

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
CONSULTA PÚBLICA Nº 32, DE 17 DE JULHO DE 2015

O Secretário do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico - PPB de COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS E MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS.

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria do Desenvolvimento da Produção, no endereço:

<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3335>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails:

cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e cgapi@suframa.gov.br.

CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA

Continuação da Consulta Pública nº 32/2015-SDP/MDIC.

ANEXO

PROPOSTA Nº 017/2015 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS E MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS.

OBS.: A consulta pública está em forma de Portaria (versão ZFM) Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para os produtos COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS, produzidos na Zona Franca de Manaus, estabelecidos pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 18, de 28 de janeiro de 2014, passam a ser conforme os artigos seguintes:

Art. 2º COMPONENTES SEMICONDUTORES e DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS:

I – corte da lâmina (wafer);

II – montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);

III – soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;

IV – moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;

V – corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;

VI – estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small Outline Packages) ou similar, quando aplicável;

VII – corte ou singularização, quando aplicável;

VIII – testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracterização ou testes optoeletrônicos; e

IX – marcação (identificação).

§ 1º Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora no País.

§ 2º Os circuitos integrados projetados no País, nos termos da Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ficam dispensados de realizar a etapa constante do inciso I do caput.

§ 3º As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores das posições 85.41 e 85.42 da NCM.

§ 4º As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores da posição 8523.51 da NCM, que utilizem a tecnologia de montagem mediante o processo chip on board (COB) diretamente em substrato, com exceção das etapas V e VI.

§ 5º Para circuitos integrados do tipo, LPDRAM, eMMC e eMCP cuja produção envolva empilhamento múltiplo de pastilha (die), poderá ser dispensado, até 31/12/2015, o cumprimento das etapas descritas nos incisos de I a VIII, em um percentual máximo de 20% do total de circuitos integrados com função de memória produzidos no ano-calendário conforme o PPB e utilizados nos termos desta Portaria. § 6º A partir de 1º/01/2016, para circuitos integrados do tipo, LPDRAM, eMMC e eMCP cuja produção envolva empilhamento múltiplo de pastilha (die), poderá ser dispensado o cumprimento das etapas descritas nos incisos de I a VII, em um percentual máximo de 20% do total de circuitos integrados com função de memória produzidos no ano-calendário conforme o PPB e utilizados nos termos desta Portaria.

§ 7º As dispensas de cumprimento de etapas listadas no caput deste artigo, mencionadas nos §§ 5º e 6º, ficam limitadas à quantidade anual de 1,5 milhão de unidades.

§ 8º Não compõem a base de cálculo sobre a qual incidirão os percentuais constantes nos §§ 5º e 6º deste artigo componentes semicondutores de memória utilizados na confecção de pen-drive e cartões microSD.

Art. 3º COMPONENTES A FILME ESPESSE OU A FILME FINO:

- I – processamento físico-químico sobre o substrato;
- II – montagem dos componentes sobre o substrato, quando aplicável;
- III – teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e
- IV – marcação (identificação).

Parágrafo único. Para a produção de circuitos integrados híbridos, ficam dispensados de atender ao disposto no caput do art. 2º desta Portaria os componentes semicondutores utilizados como insumos na produção dos mesmos.

Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:

- I – processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;
- II – corte da lâmina; e
- III – teste (ensaio).

Art. 5º MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS:

- I – corte da lâmina (wafer);
- II – montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);
- III – soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;
- IV – moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;
- V – corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;
- VI – estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small Outline Packages) ou similar, quando aplicável;
- VII – corte ou singularização, quando aplicável;
- VIII – testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracterização;
- IX – marcação (identificação); X – montagem e soldagem dos componentes na placa de circuito impresso;
- XI – gravação da memória do tipo Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EEPROM ou do circuito integrado controlador; e
- XII – testes elétricos, funcionais e etiquetagem para identificação dos módulos, quando aplicável.

§ 1º As etapas constantes dos incisos de I a X deste artigo poderão ser dispensadas em até 2% (dois por cento) do total de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 2º Poderão ser utilizados circuitos integrados monolíticos do tipo memória de acesso aleatório (Random Access Memory RAM) importados num percentual máximo de, até, 20% (vinte por cento) na montagem local dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 3º Adicionalmente ao § 2º, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos circuitos integrados do tipo memória importados utilizados na montagem dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS deverão ser marcados e testados no Brasil.

§ 4º A obrigatoriedade estabelecida no § 3º poderá ser dispensada caso a empresa fabricante opte por utilizar circuitos impressos produzidos conforme seu respectivo Processo Produtivo Básico num percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de todas as placas de circuitos impressos utilizadas na produção de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS, no ano-calendário.

§ 5º Caso o percentual dos §§ 1º a 4º não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 6º A diferença residual a que se refere o § 5º não poderá exceder a 5% (cinco por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

§ 7º Excepcionalmente para o ano de 2014, a obrigação constante no § 3º deste artigo será de 70%.

Art. 6º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção para cada produto referido no caput do art. 1º desta Portaria poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto uma, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 7º Anualmente, as empresas fabricantes deverão encaminhar à Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, até 31 de março do ano posterior, relatório contendo informações referentes à utilização dos percentuais de circuitos integrados do tipo memória e de módulos de memória montados, importados, previstos nestes artigos desta Portaria.

Parágrafo único. O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, bem como o não cumprimento dos percentuais estabelecidos nesta Portaria caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas no § 9º do art. 2º da Lei nº 8.387, de 1991 e no art. 33 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 8º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 9º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 18, de 28 de janeiro de 2014.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.